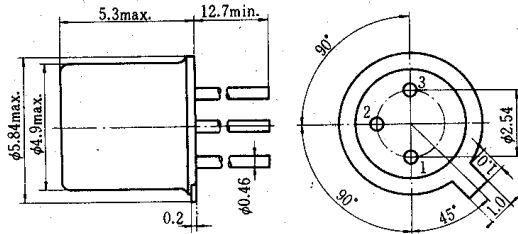


2SC1706(H)

シリコン NPN 三重拡散形
高電圧スイッチング用

SILICON NPN TRIPLE DIFFUSED
HIGH VOLTAGE SWITCHING



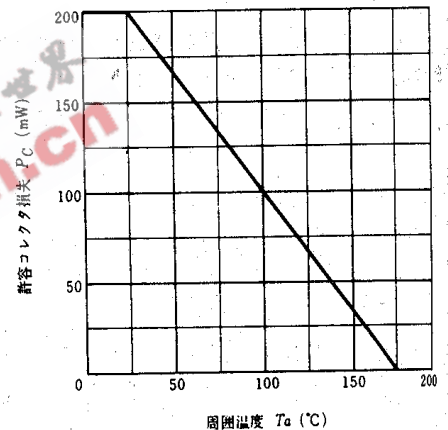
1.エミッタ: Emitter
2.ベース: Base
3.コレクタ: Collector
(ケース): (Case)
(Dimensions in mm)

(JEDEC TO-18)

■ 絶対最大定格 ABSOLUTE MAXIMUM RATINGS ($T_a=25^\circ\text{C}$)

項 目	Symbol	2SC1706(H)	Unit
コレクタ・ベース電圧	V_{CBO}	200	V
コレクタ・エミッタ電圧	V_{CES}	200	V
	V_{CEO}	150	V
エミッタ・ベース電圧	V_{EBO}	5	V
コレクタ電流	I_C	50	mA
許容コレクタ損失	P_C	200	mW
接合部温度	T_j	175	$^\circ\text{C}$
保存温度	T_{stg}	-65 ~ +175	$^\circ\text{C}$

許容コレクタ損失の周囲温度による変化 MAXIMUM COLLECTOR DISSIPATION CURVE



■ 電気的特性 ELECTRICAL CHARACTERISTICS ($T_a=25^\circ\text{C}$)

項 目	Symbol	Test Condition	min	typ	max	Unit
コレクタ・エミッタ破壊電圧	$V_{(BR)CES}$	$I_C=10\mu\text{A}, R_{BE}=0$	200	—	—	V
	$V_{(BR)CEO}$	$I_C=1\text{mA}, R_{BE}=\infty$	150	—	—	V
エミッタ・ベース破壊電圧	$V_{(BR)EBO}$	$I_E=10\mu\text{A}, I_C=0$	5	—	—	V
コレクタ遮断電流	I_{CBO}	$V_{CB}=100\text{V}, I_E=0$	—	—	0.1	μA
直流電流増幅率	h_{FE}	$V_{CE}=6\text{V}, I_C=10\text{mA}$	30	—	300	
コレクタ・エミッタ飽和電圧	$V_{CE(sat)}$	$I_C=10\text{mA}, I_B=1\text{mA}$	—	—	1.0	V
ベース・エミッタ飽和電圧	$V_{BE(sat)}$		—	—	1.5	V
高周波電流増幅率	h_{fe}	$V_{CE}=6\text{V}, I_C=10\text{mA}, f=20\text{MHz}$	3	—	—	
コレクタ出力容量	C_{ob}	$V_{CB}=6\text{V}, I_E=0, f=1\text{MHz}$	—	—	10	pF
ターンオン時間	t_{on}	$I_C=10I_{B1}=-10I_{B2}=10\text{mA}$	—	150	—	ns
ターンオフ時間	t_{off}		—	1.5	—	μs
蓄積時間	t_{stg}	$I_C=I_{B1}=-I_{B2}=20\text{mA}$	—	2.0	—	μs